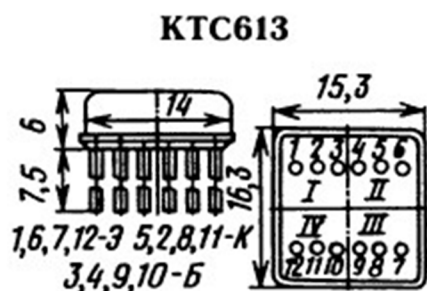


Транзисторная сборка КТС613А (2ТС613А)



2ТС613А

Транзисторные матрицы 2ТС613А, состоящие из четырех электрически изолированных кремниевых эпитаксиально-планарных структуры p-p-n переключающих высокочастотных транзисторов.

Предназначены для применения в быстродействующих импульсных и переключающих устройствах, различных каскадах вычислительных машин и другой радиоэлектронной аппаратуры.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указан на корпусе.

Масса матрицы не более 4 г.

Основные технические характеристики транзисторной сборки 2ТС613А:

Структура транзисторной сборки: p-p-n;

$P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 800 мВт;

$f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 200 МГц;

$U_{кбо\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 60 В;

$U_{эбо\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;

$I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 400 мА;

$I_{к\ и\max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 800 мА;

$I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 8 мкА (60В);

$h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 25... 100;

$C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 15 пФ;

$R_{кз\ нас}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 2,5 Ом;

$\tau_{рас}$ - Время рассасывания: не более 100 нс